


DATASHEET

IRG8CH106K10F			
Giới thiệu	IGBT 1200V 110A DIE		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IRG8CH106K10F là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRG8CH106K10F, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IRG8CH106K10F Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IRG8CH106K10F	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 110A DIE
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 110A	Điều kiện kiểm tra	600V, 110A, 1 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	80ns/380ns	Gói thiết bị nhà cung cấp	Die
Bao bì	Bulk	Gói / Case	Die
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	700nC
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased